VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf de Missebiet des Patentwesens)

		<u> </u>	MAR 2006
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2003,0796WO WEITERES VORGE		HEN	sehe Formblett PCT/PEA/416 WIPO PCT
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmelded 08.10.2004		atum (TagMonatJahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 12.11.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) ode H01L31/0232, G02B5/18	r nationale Klassifikation und	I IPK	
Anmelder AUSTRIAMICROSYSTEMS AG			
Bei diesem Bericht handelt es sic internationalen vorläufigen Prüfur Artikel 36 übermittelt wird.	h um den internationaler ng beauftragten Behörde	ı vorläufigen Prüfungst nach Artikel 35 erstellt	pericht, der von der mit der t wurde und dem Anmelder gemäß
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.			
. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen			
			itter; dabei handelt es sich um
zugrunde liegen, und/	eibung, Ansprüchen und oder Blätter mit Berichtig 07 der Verwaltungsvorsc	ungen, denen die Behi	e geändert wurden und diesem Bericht örde zugestimmt hat (siehe Regel
Gründen nach Auffas	ätter ersetzen, die aber a sung der Behörde eine Ä Idung in der ursprünglich	inderung enthalten, die	Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen e über den Offenbarungsgehalt der g hinausgeht.
b. [] (nur an das Internationale Datenträger(s) angeben) nur in computerlesbarer F 802 der Verwaltungsvorsc	, der <i>l</i> die ein Sequenzpro orm, wie im Zusatzfeld b	tokoli und <i>l</i> oder die daz	hl der/des elektronischen zugehörigen Tabellen enthält/enthalten, zprotokoll angegeben (siehe Abschnitt
4. Dieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:		
☑ Feld Nr. I Grundlage des	Bescheids		
☐ Feld Nr. II Priorität		•	
☐ Feld Nr. III Keine Erstellur Anwendbarkei	ng eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	e Tätigkeit und gewerbliche
	heitlichkeit der Erfindung		
und der gewer	blichen Anwendbarkeit; l	(2) hinsichtlich der Nei Interlagen und Erkläru	uheit, der erfinderischen Tätigkeit Ingen zur Stützung dieser Feststellung
l .	jeführte Unterlagen		
	ngel der internationalen		
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Ber	merkungen zur internatio	nalen Anmeldung	
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellun	g dieses Berichts
10.06.2005		02.03.2006	
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bedie	nsteter
Europäisches Patentamt - P NL-2280 HV Rijswijk - Pays Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 3	Bas	Bakker, J	and the state of t
Fax: +31 70 340 - 3016	•	Tel. +31 70 340-4999	Omes on Other
			BEST AVAILABLE COL

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/011304

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts		
	Hinsichtlich eingereicht	linsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie ingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	bei de	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, er es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:		
	□ Ve	ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	Anmeldeal	h der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem</i> mt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als lich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):		
	Beschreibu	ung, Seiten		
	1-10	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche	,		
	1-17	eingegangen am 10.06.2005 mit Schreiben vom 06.06.2005		
	Zeichnung	gen, Blätter		
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	☐ einen Sequenzp	n Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das protokoll		
3.	. □ Aufgr	rund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:		
		eschreibung: Seite nsprüche: Nr.		
	□ Ze	eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> :		
	□ et	twaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):		
4	aufgeliste Auffassur (Regel 70			
		eschreibung: Seite .nsprüche: Nr.		
	□ z	eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> :		
	□ et	twaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):		
	* Wenn "ersetz	n Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung zt" versehen werden.		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/011304

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-16

Nein: Ansprüche 17

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 10,13,14

Nein: Ansprüche 1-9,11,12,15-17 Ja: Ansprüche: 1-17

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-17

Nein: Ansprüche: -

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

PCT/EP2004/011304

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-3 704 377 (LEHOVEC KURT) 28. November 1972 (1972-11-28)

D3: EP-A-0 807 982 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19. November 1997 (1997-11-19)

D4: DE 195 18 303 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH) 21. November 1996 (1996-11-21)

1. Das Dokument D3 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart:

Ein optoelektronisches Bauelement mit einem Halbleiterchip, der mehrere strahlungsempfindliche Zonen (46, 50) zur Detektion elektromagnetischer Strahlung (4) aufweist, und einem optischen Element (Beugungsgitter (52)) zur Diffraktion (Spalte 2, Zeilen 10-12) der elektromagnetischen Strahlung (4) in die strahlungsempfindlichen Zonen (46,50), wobei das optische Element ein diffraktives Element (Spalte 2, Zeilen 10-12;Spalte 8, Zeilen 10-30; Spalte 10, Zeilen 1-5; Abbildungen 5 und 7) ist, das Strukturen (I, p) in der Größenordnung (p=1,8 μ m: Spalte 10, Zeile 46) der Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung (4) aufweist, und wobei der Halbleiterchip mehrere strahlungsempfindliche Zonen (46, 50) aufweist, wobei die strahlungsempfindlichen Zonen für kürzere Wellenlängen (Zone (50) für 5 μ m) in Richtung der einfallenden Strahlung (4) denen für längere Wellenlängen (Zone (46) für 10 μ m) nachgeordnet sind (Spalte 9, Zeile 42 -Spalte 10, Zeile 51; Abbildung 7).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Bauelement dadurch, daß das optische Element zur Fokussierung der elektromagnetischen Strahlung dient.

Ein zweiter, im Anspruch 1 nicht angeführter Unterschied liegt darin, daß das diffraktive Element des beanspruchten Bauelements auf der Vorderseite aufgebracht ist.

Die Möglichkeit, das Beugungsgitter auf der Vorderseite des Bauelements anzubringen, wird in D3 jedoch explizit erwähnt, siehe Spalte 2, Zeilen 4 und 5. Es ist des weiteren bekannt, daß ein diffraktives Element in der Strahlungseintrittsfläche zur Fokussierung der elektromagnetischen Strahlung führt (siehe z.B. D1: Spalte 4, Zeile 63 - Spalte 5, Zeile 6).

Deshalb kann die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

- 2. Die gleiche Begründung gilt entsprechend für die Ansprüche 15 und 16. Weiters offenbart die Druckschrift D3 einen Strukturierungsschritt einer Harzschicht (Spalte 8: Zeilen 39-46). Der Gegenstand der Ansprüche 15 und 16 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).
- Das Dokument D4 offenbart die Verwendung einer Zonenplatte (40) (D4:Abbildung 4) zur Fokussierung elektromagnetischer Strahlung (13;23;33) (Spalte 4, Zeilen 5-13) in mehrere strahlungsempfindliche Zonen (12; 22; 32) (Spalte 3, Zeile 60-64) eines strahlungsdetektierenden Halbleiterchips (10).

Der Gegenstand des Anspruchs 17 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

- 4. Der Gegenstand der Ansprüche 2-9, 11 und 12 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit, aus den folgenden Gründen:
- Anspruch 2: Die Druckschrift D4 offenbart die Verwendung einer Zonenplatte (Spalte 4, Zeilen 5-13; Abbildung 4) als diffraktives Element auf die Rückseite (D4: Abbildung 3) in einer Konfiguration wie in Abbildung 7 von Druckschrift D3.
- Ansprüche 3 und 4: Gemäß D3 ist das diffraktive Element in den Halbleiterchip integriert (Abbildung 7), und die zu detektierende Strahlung beträgt beispielsweise 5 μ m (Spalte 10, Zeile 48).
- Anspruch 5: Obwohl es sich in D3 um IR-Detektoren handelt, würde ein Fachmann erwägen das in D3 offenbarte Bauelement leicht zu modifizieren um, Licht aus dem sichtbaren Spektralbereich zu detektieren.
- Anspruch 6: Siehe D3: Spalte 10, Zeilen 41-51.

- Ansprüche 7 und 8: Die optimale Ausführung der Zonenplatte stellt eine fachübliche Maßnahme dar. Siehe zum Beispiel D4: die kleinste Ringbreite ist 1.5 μ m (Spalte 5, Zeilen 23-26).
- Anspruch 9: Gemäß D3 sind die strahlungsempfindlichen Zonen (46) und (50) genau in Fokalebenen angeordnet; vgl. die Positionsmarkierung der maximalen Intensität in Abb. 7B, die übereinstimmt mit der Mitte der unterschiedlichen Wellenlangezonen in Abb. 7A.
- Ansprüche 11 und 12: Siehe D3: Spalte 8: Zeilen 39-46.
- 5. Die im abhängigen Anspruch 10 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. Die Gründe dafür sind die folgenden: das Bauelement in Abbildung 7 von D3 enthält zwei statt drei strahlungsempfindliche Zonen zur Detektierung von IR-Strahlung. Obwohl ein Fachmann die Detektion von sichtbarem Licht in Betracht ziehen würde, wird ihm nicht nahegelegt, die Primärfarben Rot, Grün und Blau separat zu detektieren.
- 6. Die in den abhängigen Ansprüchen 13 und 14 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. Die Gründe dafür sind die folgenden:

 Das Dokument D1 (Spalte 4, Zeilen 50-52) offenbart eine Phasen-Zonenplatte aus einem transparenten Material und einem nicht-transparenten Material.

 Das Dokument D4 (Spalte 5, Zeilen 13-22) offenbart eine Phasen-Zonenplatte aus mindenstens einem absorbierenden oder reflektierenden Material.

5

10

15

20

25

30

35

11

Patentansprüche

- 1. Optoelektronisches Bauelement mit einem Halbleiterchip (2), der mehrere strahlungsempfindliche Zonen (7, 8, 9) zur Detektion elektromagnetischer Strahlung (17) aufweist, und einem optischen Element zur Fokussierung der elektromagnetischen Strahlung (17) in die strahlungsempfindliche Zone (7, 8, 9), wobei das optische Element ein diffraktives Element (1) ist, das Strukturen (14, 15) in der Größenordnung der Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung (17) aufweist, da durch gekennze ich net, das sdie strahlungsempfindlichen Zonen für kürzere Wellenlängen in Richtung der einfallenden Strahlung (17) denen für längere Wellenlängen nachgeordnet sind.
 - 2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das diffraktive Element (1) eine Zonenplatte ist.
- 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, das sdas diffraktive Element (1) in den Halbleiterchip (2) integriert ist.
- Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die zu detektierende Strahlung (17) eine Wellenlänge zwischen 100 nm und 5 μm aufweist.
- 5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, das s die zu detektierende Strahlung (17) Licht im sichtbaren Spektralbereich von etwa 400 nm bis 800 nm ist.

PCT/EP2004/011304

5

12

- 6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 da durch gekennzeichnet, da durch gekennzeichnet, das s
 - dadurch gekennzeichnet, das b der Abstand zwischen dem diffraktiven Element (1) und einer strahlungsempfindlichen Zone (7, 8, 9) weniger als 20 μm beträgt.
- 7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
- dadurch gekennzeichnet, dass
 Strahlung mit der Wellenlänge λ in einer strahlungsempfindlichen Zone (7, 8, 9) in einem Abstand R von der Zonenplatte (1) detektiert wird, wobei die Zonenplatte (1)
 einen Durchmesser D aufweist, und für die Fresnelzahl F
 der Zonenplatte (1) gilt:

$$F = (D^2 / \lambda R) > 1$$

- Optoelektronisches Bauelement nach einem der nach einem
 der Ansprüche 2 bis 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
 die Brennweite der Zonenplatte (1) für Strahlung mit der
 Wellenlänge 550 nm zwischen 1 μm und 20 μm beträgt.
- 9. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich ich net, das sdie strahlungsempfindlichen Zonen (7, 8, 9) jeweils in Fokalebenen (11, 12, 13) des diffraktiven Elements (1) für eine Farbe angeordnet sind.
 - 10. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, dass der Halbleiterchip (2) drei strahlungsempfindliche Zonen enthält (7, 8, 9), die in Fokalebenen (11, 12, 13) des

5

10

25

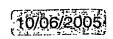
PCT/EP2004/011304

13

diffraktiven Elements (1) für jeweils eine der Primärfarben Rot, Grün und Blau angeordnet sind.

- 11. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
 das diffraktive Element (1) durch die Strukturierung einer auf den Halbleiterchip (2) aufgebrachten oder in dem
 Halbleiterchip (2) enthaltenen Schicht hergestellt ist.
 - 12. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierte Schicht eine Metallschicht ist.
- 15 13. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 2 bis 11, dadurch gekennzeich net, das s die Zonenplatte (1) als Phasen-Zonenplatte aus zwei transparenten Materialien (14, 15) mit unterschiedlichen Brechungsindizes n₁ und n₂ ausgebildet ist.
 - 14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, das seines der beiden Materialien ein Siliziumoxid und das zweite der Materialien ein Siliziumnitrid enthält.
- 15. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s

 das diffraktive optische Element (1) durch eine Strukturierung einer auf den Halbleiterchip (2) aufgebrachten
 oder in dem Halbleiterchip (2) enthaltenen Schicht hergestellt wird.
- 35 16. Verfahren nach Anspruch 15,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 der Halbleiterchip (2) einen integrierten Schaltkreis



5

14

enthält.

17. Verwendung einer Zonenplatte (1) zur Fokussierung und/oder Wellenlängenselektion elektromagnetischer Strahlung (17) in mehrere strahlungsempfindliche Zonen (7, 8, 9) eines strahlungsdetektierenden Halbleiterchips (2).

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
D BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
\square reference(s) or exhibit(s) submitted are poor quality		
OTHER:		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.